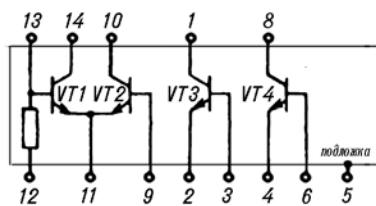


КР198НТ11

Микросхема представляет собой матрицу *n-p-n*-транзисторов. Содержит 5 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ11

Назначение выводов

1	коллектор VT3
2	эмиттер VT3
3	база VT3
4	эмиттер VT4
5	подложка
6	база VT4
7	свободный
8	коллектор VT4
9	база VT2
10	коллектор VT2
11	эмиттеры VT1 и VT2
12	резистор смещения базы VT1
13	база VT1
14	коллектор VT1

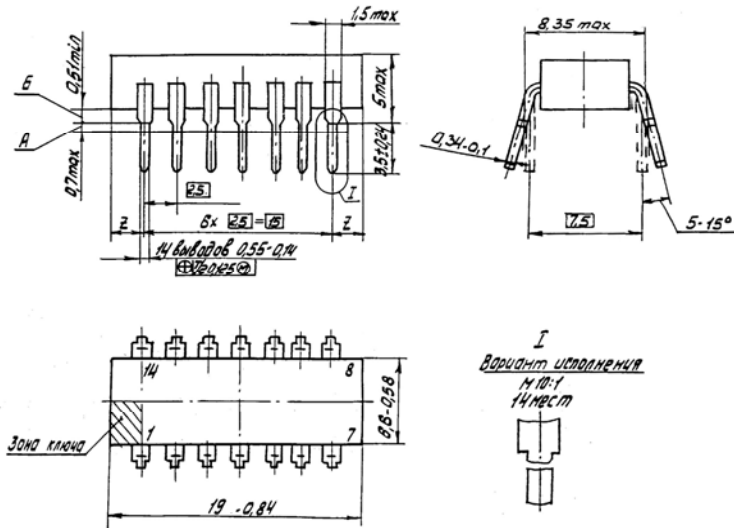
Электрические параметры

Напряжение насыщения база-эмиттер.....	≤1 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер.....	≤0,7 В
Напряжение смещения нуля дифференциальной пары.....	≤4 мВ
Обратный ток коллектора.....	≤40 нА
Статический коэффициент передачи тока.....	60...150
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары.....	≤15%

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-база.....	20 В
Напряжение эмиттер-база.....	5 В
Импульсный ток коллектора.....	≤50 мА
Импульсная рассеиваемая мощность матрицы.....	≤300 мВт
Температура окружающей среды.....	-45...+85°C

Чертеж корпуса
 Пластмассовый корпус типа 201 14-1



1. А- длина выводов, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б- ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для контакта. Допускаются капли стекла по выводам за пределы наружного контура корпуса микросхемы не более 0,5 мм на сторону.
3. Допускаются заусенцы высотой 0,04 max, сверх размера 0,18 - 0,07
4. Нумерация выводов показана условно.
5. Дно металлическое.

